

### چکیده

در این تحقیق آلومینا در فاز کروندم ( $\alpha - Al_2O_3$ ) آن که از نظر ترمودینامیکی نسبت به فازهای دیگر آن پایدارتر می باشد، انتخاب و مورد مطالعه تئوری قرار گرفته است. آلومینا دارای کاربردهای زیادی در صنعت است. سختی بالای آلومینا، باعث شده است که در برابر ساییش مقاومت داشته و از این رو کاربردهای گوناگونی در پوشش لوله ها، ظروف و واشرهای شیر آب داشته باشد. ثابت دی الکتریک بالا در کنار اتلاف دی الکتریک پایین آن در فرکانس های پایین، باعث شده است تا در موجبرها و قطعات توان بالا به کار گرفته شود. مقاومت حجمی و استقامت دی الکتریک بالایی، آلومینا را یک عایق الکتریک عالی ساخته که منجر به کاربردهای در الکترونیک، به صورت بسترها و اتصال دهندها و در مقیاس پایین به صورت عایق ها و دو شاخه های جرقه ای، شده است. مهمترین کاربرد الکتریک آن در صنعت قطعات الکترونیکی نظیر ترانزیستورهای اثر میدان به عنوان عایق گیت می باشد که می تواند جایگزینی مناسبی برای  $SiO_2$  باشد. آلومینا با ثابت دی الکتریک بالا ( $\epsilon_R = 9$ ) و با ساختار مناسب و کنترل شده ای که دارد، در نقشه راه نیم رساناهای با ابعاد نانو قرار گرفته است. برای بهبود خواص الکتریک آن، مثلاً افزایش ثابت دی الکتریک آن، می توانیم از افزودن فلزات واسط به آن کمک بگیریم.

در این پروژه تحقیقاتی از نرم افزار  $WIEN 2K$ ، که بر پایه تئوری تابعی چگالی نوشته شده، استفاده شده است. در این نرم افزار هدف حل یک مسئله بس ذره ای کوانتمی است که در حل معادله شرودینگر مربوط به آن از چگالی تابع موج به جای خود تابع موج و تقریب موج تخت افزوده شده خطی با پتانسیل کامل استفاده شده است. بعد از انجام محاسبات اولیه (محاسبات Scf)، چگالی حالتها، اتلاف انرژی الکترون نزدیک لبه ساختار

خواص اپتیکی و ساختار نواری آلومینای خالص ( $\alpha - Al_2O_3$ ) و آلومیناتهای آن با فلزات واسط گروه IIIIB با فرمول

$Al_{2-x}TxO_3$  (که در آن T فلز واسط Sc, Y, La, Ac و  $x = 0.5$  است) محاسبه و با یکدیگر و نتایج تجربی مقایسه شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که افزودن فلز واسط Y و Sc تغییر زیادی در گاف انرژی آلومینا نمی دهد اما افزودن ناخالصیهای Ac و La باعث کاهش قابل ملاحظه ای در گاف انرژی (حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد) و بنابراین افزایش ثابت دی الکتریک آن می گردد.